

# Электроупругие поля движущихся дислокаций и дисклинаций в пьезоэлектрических кристаллах

© Ш.Х. Ханнанов

Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра Российской академии наук, 450075 Уфа, Россия

E-mail: igor@physics.bash.ru

(Поступила в Редакцию 11 сентября 1998 г.  
В окончательной редакции 17 ноября 1998 г.)

В рамках четырехмерного формализма динамических функций Грина получены интегральные представления для электроупругих полей движущихся дислокаций и дисклинаций в пьезоэлектрических кристаллах. Рассмотрены случаи непрерывного распределенных и одиночных линейных дефектов. Правильность полученных результатов подтверждается выполнением требований соответствия при переходе к чисто упругому решению.

Линейные дефекты кристаллической решетки являются объектом исследования с точки зрения как механических [1], так и электрических [2] свойств. Природа электрической активности дефектов зависит от рода кристаллов. Здесь речь пойдет о пьезоэлектрических кристаллах [3–5], в которых благодаря электрической поляризации линейные дефекты обладают связанными электроупругими полями [6–8]. Теоретическое исследование этих полей — весьма актуальная задача, привлекавшая внимание ряда исследователей [6–8].

В случае чисто упругого тела с использованием функций Грина были получены общие решения для произвольных распределений движущихся дислокаций и дисклинаций [9,10]. При этом упругие поля полностью выражаются через плотности и потоки дефектов. В случае пьезоупругого тела такое общее решение для электроупругих полей произвольно распределенных движущихся линейных дефектов (дислокаций и дисклинаций) до настоящего времени не было получено. Попытку, сделанную в работе [8], нельзя считать вполне успешной, так как решение в ней выражается не через потоки дефектов, а через макроскопические величины скоростей пластической деформации и пластического изгиба-кручения. Цель настоящей работы — восполнение указанного пробела.

## 1. Формулировка задачи

В континуальной теории исходят из предположения, что линейные дефекты (дислокации и дисклинации) эквивалентны некоторым пластическим (сингулярным) базисным полям [9]. Последние, как будет показано далее, можно заменить распределениями фиктивных объемных сил  $f_i$  и зарядов  $g$ . Поэтому задача определения электроупругих полей дефектов сводится к некоторой задаче пьезоупругости при заданных  $f_i$  и  $g$ .

Рассмотрим пьезоэлектрический кристалл, который характеризуется тензорами упругих  $\lambda_{ijkl}$ , диэлектрических  $\varepsilon_{ij}$  и пьезоэлектрических  $\beta_{kij}$  констант (обозначения согласно [3], §17), удовлетворяющими известным свойствам симметрии [3–5]. Здесь и далее, если это не огово-

рено особо, индексы, обозначенные малыми латинскими буквами, принимают значения 1, 2, 3. Константы входят в линейные уравнения состояния, связывающие упругие напряжения  $\sigma_{ij}$  и электрические смещения  $D_i$  с упругими деформациями  $e_{kp}$  и напряженностью электрического поля  $E_k$  [3–5]. Выражая  $e_{kp}$  через вектор упругого смещения  $u_p$  в виде  $e_{pk} = (u_{p,k} + u_{k,p})/2$ , а  $E_i$  — через электрический потенциал  $\varphi$  в виде  $E_i = -\varphi_{,i}$ , указанные уравнения состояния можно записать следующим образом [3–5]:  $\sigma_{ij} = \lambda_{ijkp}u_{p,k} + \beta_{kij}\varphi_{,k}$ ;  $D_i = \beta_{ikp}u_{p,k} - \varepsilon_{ij}\varphi_{,j}$ . Здесь индекс после запятой означает дифференцирование по соответствующей координате.

Для определения смещения  $u_i$  и потенциала  $\varphi$  при заданных  $f_i$  и  $g$  имеем уравнения движения частиц тела (уравнения теории упругости) [4]  $\sigma_{ij,j} - \rho\ddot{u}_i = -f_i$  и уравнение электростатики [3]  $D_{i,j} = g$ , где  $\rho$  — плотность тела, точка сверху означает дифференцирование по времени. Подставляя в эти уравнения выражения для  $\sigma_{ij}$  и  $D_i$ , получаем неоднородные уравнения, содержащие только  $u_k$  и  $\varphi$ ,

$$\lambda_{ijkp}u_{k,pj} - \rho\ddot{u}_i + \beta_{kij}\varphi_{,kj} = -f_i, \quad (1)$$

$$\beta_{jkp}u_{k,pj} - \varepsilon_{jk}\varphi_{,jk} = -g. \quad (2)$$

Теперь в уравнениях (1), (2) необходимо выразить  $f_i$  и  $g$  через базисные пластические поля линейных дефектов.

Согласно [9], тело с движущимися дислокациями и дисклинациями характеризуется набором базисных пластических полей: деформации  $e_{ij}^p$ , изгиба-кручения  $\chi_{ij}^p$ , скорости  $v_i^p$  и поворота  $\omega_q^p$ . Как показано в [9] (см. также [11]), пластическую скорость  $v_i^p$  можно для физических дефектов положить равной нулю. Величины  $\chi_{ij}^p$  и  $\omega_q^p$  не входят в уравнения состояния. Поэтому  $f_i$  и  $g$  будут определяться фактически только пластической деформацией  $e_{ij}^p$ . При наличии  $e_{ij}^p \neq 0$  имеем

$$e_{kp} = e_{kp}^T - e_{kp}^p = \frac{1}{2}(u_{p,k} + u_{k,p}) - e_{kp}^p, \quad (3)$$

где  $e_{kp}^T$  — полная (пластическая плюс упругая) деформация, а в уравнениях (1), (2) полагаем  $f_i = g = 0$  (роль

внешних сил и электрических зарядов играют теперь базисные пластические поля дефектов). С учетом этого уравнения (1), (2) принимают вид

$$\lambda_{ijkp} = u_{k,pj} - \rho \ddot{u}_i + \beta_{kij} \varphi_{,kj} = \lambda_{ijkp} e_{pk,j}^P, \quad (4)$$

$$\beta_{jkp} u_{k,pj} - \varepsilon_{jk} \varphi_{,jk} = \beta_{jkp} e_{pk,j}^P \quad (5)$$

Сравнивая уравнения (1), (2) и (4), (5), видим, что линейные дефекты в пьезокристалле эквивалентны распределению фиктивных объемных сил  $f_i$  и зарядов  $g$ , величина которых определяется равенством

$$f_i = -\lambda_{ijkp} e_{pk,j}^P, \quad (6)$$

$$g = -\beta_{jkp} e_{pk,j}^P. \quad (7)$$

Задача состоит в интегрировании неоднородных уравнений (4), (5). В общем виде это можно сделать, используя формализм функций Грина.

## 2. Четырехмерный формализм функций Грина

В силу симметрии материальных констант и уравнений задачи (1), (2) удобно ввести четырехмерные динамические тензорные функции Грина  $G_{\alpha\beta}(\mathbf{r}, t)$ , где  $\mathbf{r}$  — радиус-вектор,  $t$  — время; индексы, обозначенные греческими буквами, принимают значения 1, 2, 3, 4. В статическом случае такие функции Грина вводились в работе [12].

Произведя преобразование Фурье

$$\bar{f}(\omega, \mathbf{k}) = \iint f(\mathbf{r}, t) \exp[i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)] d\mathbf{r} dt,$$

уравнения (1), (2) можно представить в матричной форме

$$D_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k}) \bar{U}_\beta(\omega, \mathbf{k}) = \bar{F}_\alpha(\omega, \mathbf{k}), \quad (8)$$

где  $(4 \times 2)$ -матрица  $D_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k})$  имеет вид ( $\delta_{ik}$  — символ Кронекера)

$$D_{ik} = \lambda_{ijkp} k_p k_j - \rho \omega^2 \delta_{ik},$$

$$D_{i4} = D_{4i} = \beta_{kij} k_j k_k, \quad D_{44} = -\varepsilon_{jk} k_j k_k,$$

а компоненты четырехмерных векторов  $U_\alpha$  и  $F_\alpha$  равны

$$U_i = u_i, \quad U_4 = \varphi,$$

$$F_i = -f_i, \quad F_4 = -g.$$

Исходя из вида уравнения (8), Фурье-трансформанту функции Грина  $\bar{G}_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k})$  определим соотношением

$$D_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k}) \bar{G}_{\beta\gamma}(\omega, \mathbf{k}) = \delta_{\alpha\gamma}, \quad (9)$$

где  $\delta_{\alpha\gamma}$  — четырехмерный аналог символа Кронекера. Умножая обе части (9) на матрицу  $D_{\alpha\beta}^{-1}(\omega, \mathbf{k})$ , находим

$$\bar{G}_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k}) = \frac{d_{\beta\alpha}(\omega, \mathbf{k})}{D(\omega, \mathbf{k})}, \quad (10)$$

где  $D(\omega, \mathbf{k})$  — определитель матрицы  $D_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k})$ ,  $d_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k})$  — алгебраическое дополнение элемента  $D_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k})$ .

В соответствии с видом уравнений (8), (9) функция Грина  $G_{\alpha\beta}$  описывает отклики пьезоупругого тела различного типа: смещение-сила (компоненты  $G_{ik}$ ), потенциал-сила (компоненты  $G_{4k}$ ), смещение-заряд (компоненты  $G_{i4}$ ) и потенциал-заряд (компоненты  $G_{44}$ ).

В дальнейшем нам понадобится также уравнение для  $G_{\alpha\beta}(\mathbf{r}, t)$ . Путем обратного преобразования Фурье над уравнением (9) получаем

$$\hat{D}_{\alpha\beta} \left( -i \frac{\partial}{\partial t}, i \frac{\partial}{\partial x_p} \right) G_{\beta\gamma}(\mathbf{r}, t) = \delta_{\alpha\gamma} \delta(\mathbf{r}) \delta(t), \quad (11)$$

где  $\hat{D}_{\alpha\beta}(-i\partial/\partial t, i\partial/\partial x_p)$  — матрица с операторными элементами, которая получается из матрицы  $D_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k})$  путем подстановки  $\omega \rightarrow -i\partial/\partial t$ ,  $k_p \rightarrow i\partial/\partial x_p$ .

## 3. Электроупругие поля линейных дефектов

Решение основного уравнения (8) дается равенством

$$\bar{U}_\gamma = \bar{G}_{\gamma\alpha} \bar{F}_\alpha$$

или после обратного преобразования Фурье

$$U_\alpha(\mathbf{r}, t) = \iint G_{\alpha\beta}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') F_\beta(\mathbf{r}', t') d\mathbf{r}' dt',$$

где  $U_\alpha = (u_i, \varphi)$ ,  $F_\beta = (-f_i, g)$ . Подставляя сюда выражения (6), (7) для плотности фиктивных объемных сил  $f_i$  и зарядов  $g$ , получаем выражения для смещений  $u_i$  и электрического потенциала  $\varphi$ , создаваемых движущимися дефектами

$$u_i(\mathbf{r}, t) = - \iint \left\{ G_{iq}(\mathbf{R}, T) \lambda_{qjkp} e_{pk,j}^P(\mathbf{r}', t') + G_{4i}(\mathbf{R}, T) \beta_{ikp} e_{pk,j}^P(\mathbf{r}', t') \right\} d\mathbf{r}' dt', \quad (12)$$

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = - \iint \left\{ G_{4q}(\mathbf{R}, T) \lambda_{qjkp} e_{pk,j}^P(\mathbf{r}', t') + G_{44}(\mathbf{R}, T) \beta_{ikp} e_{pk,j}^P(\mathbf{r}', t') \right\} d\mathbf{r}' dt', \quad (13)$$

где  $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ ,  $T = t - t'$ .

Формулы (12), (13) содержат макроскопическую характеристику  $e_{pk}^P$  — тензор пластической деформации. Чтобы исключить макроскопические характеристики и выразить электроупругие поля через характеристики дефектов (тензоры плотности и потока), необходимо проделать процедуру преобразований решения (12), (13), которая во многом аналогична преобразованиям в работе [10] в случае чистой упругости. При этом используются уравнения (11) для функции Грина, а также определяющие соотношения для тензоров плотности  $\alpha_{ik}$ ,

$\theta_{ik}$  и потока  $J_{kl}$ ,  $S_{kq}$  дислокаций и дисклинаций [9] (см. также [11])

$$\alpha_{pl} = -\varepsilon_{pmk} (e_{kl,m}^P + \varepsilon_{klq} z_{mq}^P),$$

$$\theta_{pq} = -\varepsilon_{pmk} z_{kq,m}^P,$$

$$J_{kl} = \dot{e}_{kl}^P + \varepsilon_{klq} \omega_q^P,$$

$$S_{kq} = -\omega_{q,k}^P + z_{kq}^P.$$

Здесь, как и выше, положили пластическую скорость  $v_i^P = 0$ , что не сказывается на конечных результатах.

Не приводя подробные выкладки, запишем сразу окончательные выражения для тензора упругой деформации  $e_{mn}$  и вектора электрической напряженности  $E_k$

$$e_{mn}(\mathbf{r}, t) = \iint \left\{ \left[ \varepsilon_{pmk} C_{\alpha ikl} G_{\alpha n,i} \alpha_{pl} - \rho \dot{G}_{ln} J_{ml} \right] - \varepsilon_{pmk} \left[ \varepsilon_{qsl} C_{\alpha ikl} H_{\alpha n,is} \theta_{pq} - \rho \dot{H}_{kn,s} S_{sp} \right] \right\}_{(mn)} d\mathbf{r}' dt', \quad (14)$$

$$E_m(\mathbf{r}, t) = \iint \left\{ \left[ \varepsilon_{pmk} C_{\alpha ikl} G_{\alpha 4,i} \alpha_{pl} - \rho \dot{G}_{l4} J_{ml} \right] - \varepsilon_{pmk} \left[ \varepsilon_{qsl} C_{\alpha ikl} H_{\alpha 4,is} \theta_{pq} - \rho \dot{H}_{k4,s} S_{sp} \right] \right\}_{(mn)} d\mathbf{r}' dt', \quad (15)$$

где  $mn$  — операция симметризации,  $\varepsilon_{pmk}$  — единичный антисимметричный тензор и для простоты записи опущены аргументы  $(\mathbf{R}, T)$  у функций Грина  $G_{\alpha\beta}$  и потенциалов  $H_{\alpha\beta}$ , а также аргументы  $(\mathbf{r}', t')$  у функций  $\alpha_{pl}$ ,  $\theta_{pq}$ ,  $J_{ml}$ ,  $S_{sp}$ . Здесь введен тензор материальных констант  $C_{\alpha\beta\delta\gamma}$ , у которого  $C_{jikl} = \lambda_{jikl}$ ,  $C_{4ikl} = \beta_{ikl}$ , а остальные компоненты равны нулю. Потенциалы  $H_{\alpha\beta}(\mathbf{r}, t)$  определяются согласно [10]

$$H_{\alpha\beta}(\mathbf{r}, t) = \int G_{\alpha\beta}(\mathbf{r}', t) (2\pi R)^{-1} d\mathbf{r}'.$$

При переходе к чисто упругому случаю, когда  $C_{4ikl} = \beta_{ikl} = 0$ ,  $G_{\alpha 4}$  и  $H_{\alpha 4}$  обращаются в соответствии с уравнением (9) в нуль, а электрическое поле  $E_m$  исчезает (15). В этом случае из (14) следует выражение

$$e_{mn}(\mathbf{r}, t) = \iint \left\{ \left[ \varepsilon_{pmk} \lambda_{jikl} G_{jn,i} \alpha_{pl} - \rho \dot{G}_{ln} J_{ml} \right] - \varepsilon_{pmk} \left[ \varepsilon_{qsl} \lambda_{jikl} H_{jn,is} \theta_{pq} - \rho \dot{H}_{kn,s} S_{sp} \right] \right\}_{(mn)} d\mathbf{r}' dt',$$

которое совпадает с выражением (4.6) из работы [10], что является подтверждением правильности полученных результатов.

Решения (14), (15) справедливы при произвольном распределении движущихся дислокаций и дисклинаций. Отсюда легко получить решения для случая одиночных дефектов. Для этого необходимо подставить в (14), (15)

известные выражения [10] для плотностей

$$\alpha_{pl}(\mathbf{r}, t) = \oint_{L(t)} \delta(\mathbf{R}) \{ b_l + \varepsilon_{lqr} \Omega_q (x'_r - x_r^0) \} dL'_p,$$

$$\theta_{pq}(\mathbf{r}, t) = \oint_{L(t)} \delta(\mathbf{R}) \Omega_q dL'_p$$

и потоков

$$J_{kl}(\mathbf{r}, t) = \oint_{L(t)} \varepsilon_{pmk} \delta(\mathbf{R}) \{ b_l + \varepsilon_{lqr} \Omega_q (x'_r - x_r^0) \} v_m(\mathbf{r}', t') dL'_p,$$

$$S_{kq}(\mathbf{r}, t) = \oint_{L(T)} \varepsilon_{pmk} \delta(\mathbf{R}) \Omega_q v'_m(\mathbf{r}', t) dL'_p$$

дислокаций и дисклинаций одиночного линейного дефекта и произвести интегрирование. Здесь  $L(t)$  — линия дефекта;  $x_r^0$  — координата точки на оси поворота;  $b_l$  — вектор Бюргера дислокации, связанной с линией дефекта;  $\Omega_q$  — вектор Франка,  $v_m$  — скорость движения  $L(t)$ . В результате интегрирования с учетом свойств дельта-функций получаем

$$e_{mn}(\mathbf{r}, t) = \iint_{L(t)} \left\{ \varepsilon_{pmk} (C_{\alpha ikl} G_{\alpha n,i} + \rho \dot{G}_{ln} v'_k) \times (b_l + \varepsilon_{lqr} \Omega_q (x'_r - x_r^0)) - \varepsilon_{qmk} \varepsilon_{psl} (C_{\alpha ikl} H_{\alpha n,is} + \rho \dot{H}_{kn,s} v'_l) \Omega_q \right\} dL'_p dt'_{(mn)}, \quad (16)$$

$$E_m(\mathbf{r}, t) = \iint_{L(t)} \left\{ \varepsilon_{pmk} (C_{\alpha ikl} G_{\alpha 4,i} + \rho \dot{G}_{l4} v'_k) \times (b_l + \varepsilon_{lqr} \Omega_q (x'_r - x_r^0)) - \varepsilon_{qmk} \varepsilon_{psl} (C_{\alpha ikl} H_{\alpha 4,is} + \rho \dot{H}_{k4,s} v'_l) \Omega_q \right\} dL'_p dt', \quad (17)$$

При переходе к чисто упругому случаю электрическое поле  $E_m$  исчезает, а выражение (16) совпадает с выражением (5.7) из работы [10]. Тензор упругих напряжений  $\sigma_{ij}$  и вектор электрического смещения  $D_i$ , создаваемые движущимися линейными дефектами, можно найти с помощью уравнений состояния [3–5], подставляя в них полученные выражения (14), (15) или (16), (17) для упругих деформаций  $e_{mn}$  и вектора напряженности электрического поля  $E_m$ .

Таким образом, получены общие решения для электроупругих полей движущихся дислокаций и дисклинаций в пьезоэлектрических кристаллах. При этом физические наблюдаемые поля определяются через тензоры плотности и потока дислокаций и дисклинаций, которые следует считать заданными.

## Список литературы

- [1] Б.И. Смирнов. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. Наука, Л. (1981). 275 с.
- [2] Ю.А. Осипьян, В.Ф. Петренко. В кн.: Проблемы прочности и пластичности твердых тел / Отв. ред. С.Н. Журков. Наука, Л. (1979). С. 118–128.
- [3] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1982). 620 с.
- [4] Ю.И. Сиротин, М.П. Шаскольская. Основы кристаллофизики. Наука, М. (1975). 680 с.
- [5] Дж. Най. Физические свойства кристаллов. Мир, М. (1960). 386 с.
- [6] А.М. Косевич, Л.А. Пастур, Э.П. Фельдман. Кристаллография **12**, 5, 916 ((1967).
- [7] I.S. Smirnova. Phys. Stat. Sol. (b) **126**, 1, 177 (1984).
- [8] S. Minagawa. Phys. Stat. Sol. (b) **124**, 2, 565 (1984).
- [9] E. Kossecka, R. De Wit. Archives of Mech. **29**, 5, 633 (1979).
- [10] E. Kossecka, R. De Wit. Archives of Mech. **29**, 6, 749 (1979).
- [11] Ш.Х. Ханнанов. ФММ **49**, 1, 59 (1980).
- [12] Н.А. Перцев, К.В. Смирнов. Кристаллография **33**, 6, 1335 (1988).